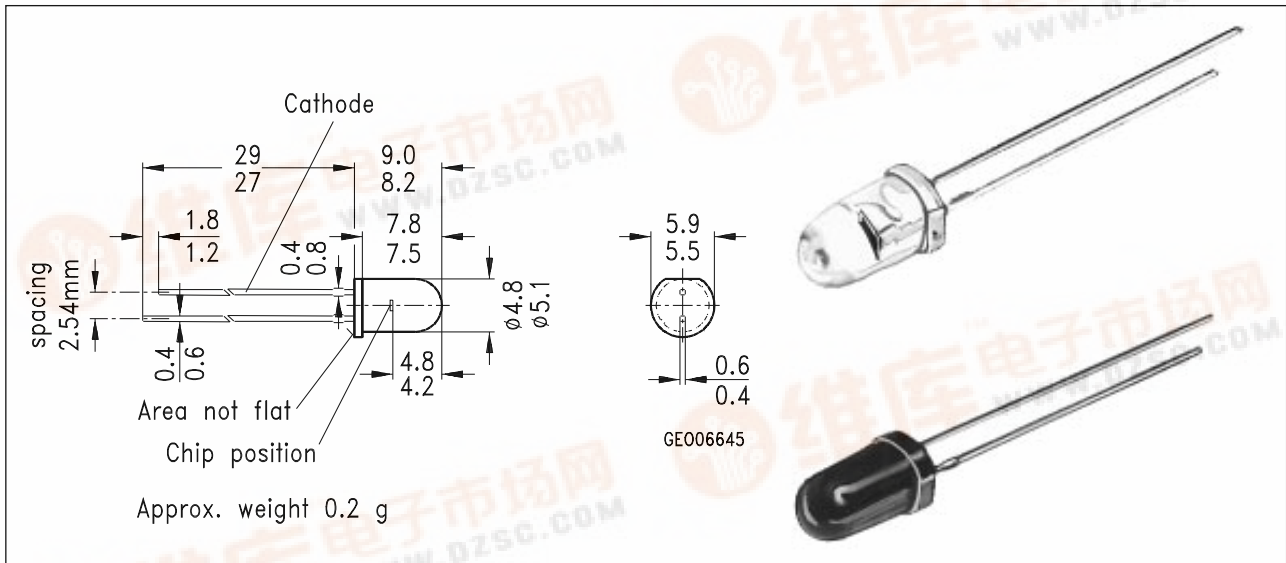


SIEMENS

Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit
Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
Silicon PIN Photodiode with Very Short Switching Time
Silicon PIN Photodiode with Daylight Filter

SFH 2030
SFH 2030 F



Maße in mm, wenn nicht anders angegeben/Dimensions in mm, unless otherwise specified.

Wesentliche Merkmale

- Speziell geeignet für Anwendungen im Bereich von 400 nm bis 1100 nm (SFH 2030) und bei 880 nm (SFH 2030 F)
- Kurze Schaltzeit (typ. 5 ns)
- 5 mm-Plastikbauform im LED-Gehäuse
- Auch gegurtet lieferbar

Anwendungen

- Industrieelektronik
- "Messen/Steuern/Regeln"
- Schnelle Lichtschranken für Gleich- und Wechsellichtbetrieb
- LWL

Features

- Especially suitable for applications from 400 nm to 1100 nm (SFH 2030) and of 880 nm (SFH 2030 F)
- Short switching time (typ. 5 ns)
- 5 mm LED plastic package
- Also available on tape

Applications

- Industrial electronics
- For control and drive circuits
- Light-reflecting switches for steady and varying intensity
- Fiber optic transmission systems

Typ (*ab 4/95) Type (*as of 4/95)	Bestellnummer Ordering Code	Gehäuse Package
SFH 2030 (*SFH 203)	Q62702-P955	T1 ³ / ₄ , klares bzw schwarzes Epoxy-Gießharz, Lötspieße im 2.54-mm-Raster (¹ / ₁₀), Kathodenkennzeichnung: kürzerer Lötspieß, flach am Gehäusebund
SFH 2030 F (*SFH 203 FA)	Q62702-P956	transparent and black epoxy resin, solder tab 2.54 mm (¹ / ₁₀) lead spacing, cathode marking: short solder tab, flat at package

Grenzwerte Maximum Ratings

Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Betriebs- und Lagertemperatur Operating and storage temperature range	$T_{op}; T_{stg}$	-55 ... +100	°C
Löttemperatur (Lötstelle 2 mm vom Gehäuse entfernt bei Lötzeit $t \leq 3s$) Soldering temperature in 2 mm distance from case bottom ($t \leq 3s$)	T_S	300	°C
Sperrspannung Reverse voltage	V_R	50	V
Verlustleistung Total power dissipation	P_{tot}	100	mW

Kennwerte ($T_A = 25\text{ °C}$) Characteristics

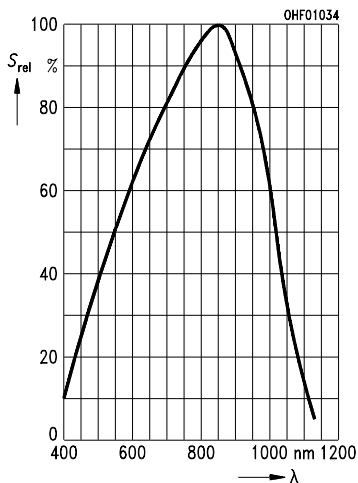
Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value		Einheit Unit
		SFH 2030	SFH 2030 F	
Fotoempfindlichkeit Spectral sensitivity $V_R = 5\text{ V}$, Normlicht/standard light A, $T = 2856\text{ K}$, $V_R = 5\text{ V}$, $\lambda = 950\text{ nm}$, $E_e = 0.5\text{ mW/cm}^2$	S	80 (≥ 50)	–	nA/lx
	S	–	25 (≥ 15)	μA
Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit Wavelength of max. sensitivity	$\lambda_{S\text{ max}}$	850	900	nm
Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit $S = 10\%$ von S_{max} Spectral range of sensitivity $S = 10\%$ of S_{max}	λ	400 ... 1100	800 ... 1100	nm
Bestrahlungsempfindliche Fläche Radiant sensitive area	A	1	1	mm^2
Abmessung der bestrahlungsempfindlichen Fläche Dimensions of radiant sensitive area	$L \times B$	1 x 1	1 x 1	mm
	$L \times W$			
Abstand Chipoberfläche zu Gehäuseoberfläche Distance chip front to case surface	H	4.0 ... 4.6	4.0 ... 4.6	mm

Kennwerte ($T_A = 25\text{ °C}$)

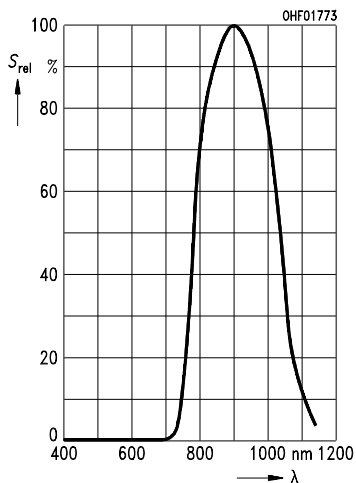
Characteristics

Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value		Einheit Unit
		SFH 2030	SFH 2030 F	
Halbwinkel Half angle	φ	± 20	± 20	Grad deg.
Dunkelstrom, $V_R = 20\text{ V}$ Dark current	I_R	1 (≤ 5)	1 (≤ 5)	nA
Spektrale Fotoempfindlichkeit, $\lambda = 850\text{ nm}$ Spectral sensitivity	S_λ	0.62	0.59	A/W
Quantenausbeute, $\lambda = 850\text{ nm}$ Quantum yield	η	0.89	0.86	<u>Electrons</u> Photon
Leerlaufspannung Open-circuit voltage $E_V = 1000\text{ lx}$, Normlicht/standard light A, $T = 2856\text{ K}$ $E_e = 0.5\text{ mW/cm}^2$, $\lambda = 950\text{ nm}$	V_L V_L	420 (≥ 350) –	– 370 (≥ 300)	mV mV
Kurzschlußstrom Short-circuit current $E_V = 1000\text{ lx}$, Normlicht/standard light A, $T = 2856\text{ K}$ $E_e = 0.5\text{ mW/cm}^2$, $\lambda = 950\text{ nm}$	I_K I_K	80 –	– 25	μA μA
Anstiegs und Abfallzeit des Fotostromes Rise and fall time of the photocurrent $R_L = 50\text{ k}\Omega$; $V_R = 20\text{ V}$; $\lambda = 850\text{ nm}$; $I_p = 800\text{ }\mu\text{A}$	t_r, t_f	5	5	ns
Durchlaßspannung, $I_F = 80\text{ mA}$, $E = 0$ Forward voltage	V_F	1.3	1.3	V
Kapazität, $V_R = 0\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$, $E = 0$ Capacitance	C_0	11	11	pF
Temperaturkoeffizient von V_L Temperature coefficient of V_L	TC_V	–2.6	–2.6	mV/K
Temperaturkoeffizient von I_K , Temperature coefficient of I_K Normlicht/standard light A $\lambda = 950\text{ nm}$	TC_I	0.18 –	– 0.2	%/K
Rauschäquivalente Strahlungsleistung Noise equivalent power $V_R = 10\text{ V}$, $\lambda = 850\text{ nm}$	NEP	2.9×10^{-14}	2.9×10^{-14}	$\frac{\text{W}}{\sqrt{\text{Hz}}}$
Nachweisgrenze, $V_R = 20\text{ V}$, $\lambda = 850\text{ nm}$ Detection limit	D^*	3.5×10^{12}	3.5×10^{12}	$\frac{\text{cm} \cdot \sqrt{\text{Hz}}}{\text{W}}$

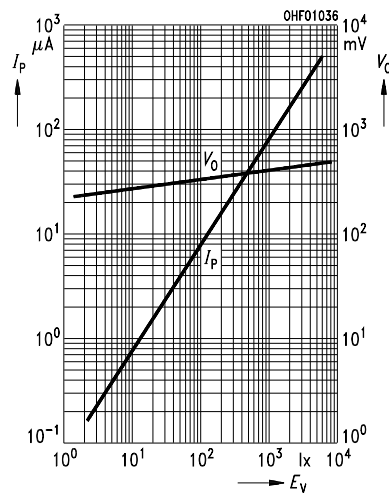
Relative spectral sensitivity SFH 2030
 $S_{rel} = f(\lambda)$



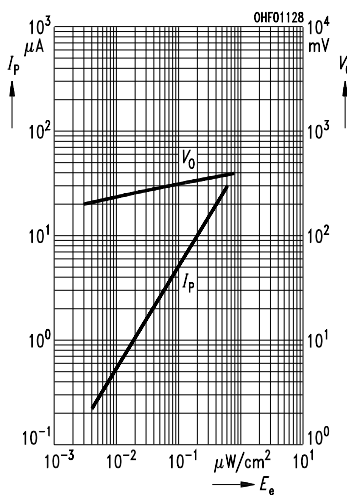
Relative spectral sensitivity SFH 2030 F
 $S_{rel} = f(\lambda)$



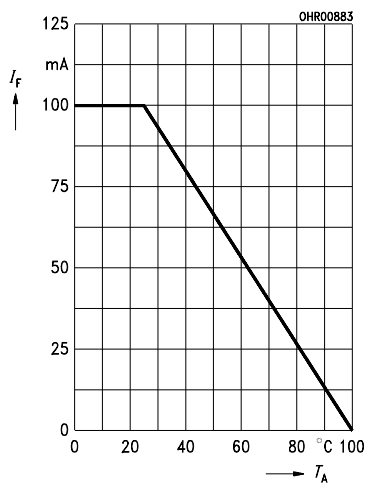
Photocurrent $I_P = f(E_V)$, $V_R = 5 V$
Open-circuit-voltage $V_L = f(E_V)$
SFH 2030



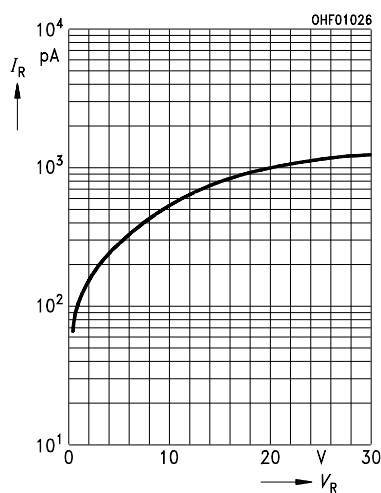
Photocurrent $I_P = f(E_e)$, $V_R = 5 V$
Open-circuit-voltage $V_L = f(E_e)$
SFH 2030 F



Total power dissipation $P_{tot} = f(T_A)$



Dark current
 $I_R = f(V_R), E = 0$



Directional characteristics $S_{rel} = f(\varphi)$

